

発明の名称:半導体基板の製造方法

利用・用途・応用分野

半導体基板の製造方法の技術分野 高品質の半導体発光・電子デバイス装置の製造

目的・課題

ベース基板上に結晶品質が良好な半導体層を得ること

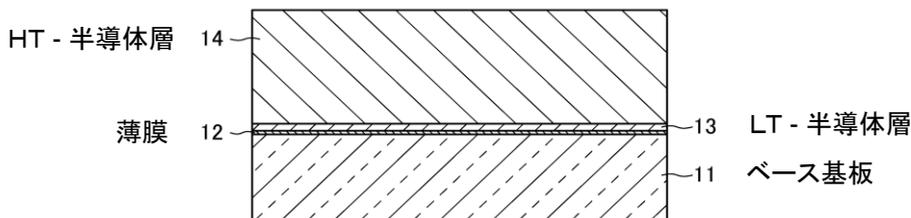
解決ポイント

- ①半導体基板の製造方法では、ベース基板11の表面を、多数の開口が形成された薄膜12で被覆する。
- ②薄膜12の多数の開口から露出したベース基板11の表面から相対的に低温で半導体を堆積させて、薄膜上にLT-半導体層13を形成する。
- ③LT-半導体層13から相対的に高温で半導体を結晶成長させてLT-半導体層13上にHT-半導体層14を形成する。

研究概要・アピールポイント

ベース基板の表面を被覆する薄膜に形成された多数の開口から、露出したベース基板の表面から相対的に、低温で半導体を堆積させて、薄膜上にLT-半導体層を形成した後、LT-半導体層から相対的に高温で半導体を結晶成長させて、LT-半導体層上にHT-半導体層を形成することにより、ベース基板上に結晶品質が良好なHT-半導体層を得ることができる。

【 HT-半導体層の形成を示す説明図 】



◆ お問い合わせ先 ◆

有限会社山口ティール・エル・オー TEL: 0836-22-9768 E-mail:tlojim@yamaguchi-u.ac.jp